

NチャネルパワーMOS-FET

N-CHANNEL SILICON POWER MOS-FET

F-II SERIES

A
2

■特長：Features

- スイッチングスピードが速い High speed switching
- オン抵抗が低い Low on-resistance
- 2次降伏がない No secondary breakdown
- 駆動電力が小さい Low driving power
- 高耐圧である High voltage
- $V_{GS} = \pm 30V$ 保証 $V_{GS} = \pm 30V$ Guarantee

■用途：Applications

- スイッチング電源 Switching regulators
- UPS UPS
- DC/DCコンバータ DC-DC converters
- 一般電力増幅 General purpose power amplifier

■定格と特性：Max. Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings($T_c = 25^\circ C$)

Items	Symbols	Ratings	Units
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}	900	V
ドレイン電流	I_D	3.5	A
パルスドレイン電流	$I_{D(pulse)}$	9	A
ドレイン逆電流	I_{DS}	3.5	A
ゲート・ソース電圧	V_{GS}	± 30	V
許容損失電力	P_D	80	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ C$

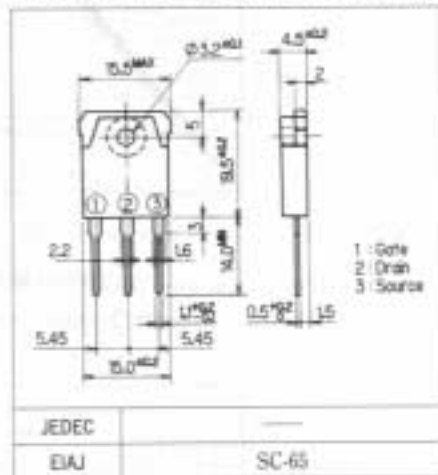
●電気的特性：Electrical Characteristics($T_c = 25^\circ C$)

Items	Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
ドレイン・ソース降伏電圧	$V_{DS(BOSS)}$	$I_D = 1mA$ $V_{GS} = 0V$	900			V
ゲートしきい値電圧	$V_{GS(th)}$	$I_D = 1mA$ $V_{DS} = V_{GS}$	2.5	3.5	5.0	V
ドレインしゃ断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 900V$		10	500	μA
		$V_{GS} = 0V$		0.2	1.0	mA
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$ $V_{DS} = 0V$		10	100	nA
オン抵抗	$R_{DS(on)}$	$I_D = 2A$ $V_{GS} = 10V$		4.0	5.5	Ω
順伝達コンダクタンス	g_{fs}	$I_D = 2A$ $V_{DS} = 25V$	2.0	4.0		S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 25V$		800	1200	pF
出力容量	C_{oss}	$V_{GS} = 0V$		80	120	
転送容量	C_{rsw}	$f = 1MHz$		30	90	
ターンオン時間	t_{turn}	$V_{CC} = 600V$ $I_D = 4A$ $V_{GS} = 10V$ $R_{\theta} = 25\Omega$		30	45	ns
	t_r			65	100	
	t_{fall}			110	165	
ターンオフ時間	t_f		60	90		
ダイオード順電圧	V_{SD}	$I_F = 2 \times I_{DS}$ $V_{GS} = 0V$ $T_{ch} = 25^\circ C$		0.90	1.35	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_F = I_{DS}$ $di/dt = 100A/\mu s$ $T_{ch} = 25^\circ C$		700		ns

●熱的特性：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
熱抵抗	$R_{th(ch-a)}$	channel to air			35.0	$^\circ C/W$
	$R_{th(ch-c)}$	channel to case			1.56	$^\circ C/W$

■外形寸法：Outline Drawings



■等価回路

Equivalent Circuit Schematic

